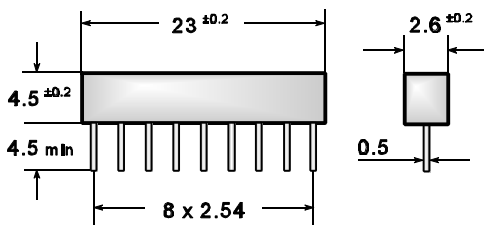


**Fast Switching Rectifier Arrays**
**Schnelle Gleichrichter Sätze**


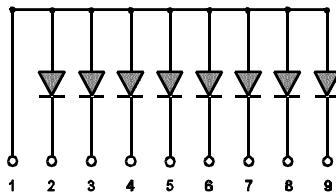
Dimensions / Maße in mm

 Nominal power dissipation 1.2 W  
 Nenn-Verlustleistung

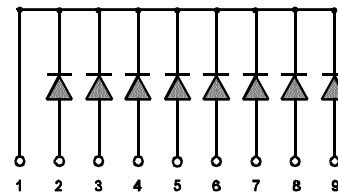
 Repetitive peak reverse voltage 100...1000 V  
 Periodische Spitzensperrspannung

 9 Pin-Plastic case 23 x 2.6 x 4.5 [mm]  
 9 Pin-Kunststoffgehäuse

 Standard packaging: bulk  
 Standard Lieferform: lose im Karton

 Weight approx. 0,6 g  
 Gewicht ca.


"DAF 811 A...8110 A": com. anodes / gem. Anode



"DAF 811 K...8110 K" : com. kathodes / gem. Kathode

**Maximum ratings**
**Grenzwerte**

Type	Repetitive peak reverse voltage	Surge peak reverse voltage
Typ	Periodische Spitzensperrspannung	Stoßspitzensperrspannung
	$V_{RRM}$ [V]	$V_{RSM}$ [V]
DAF 811 A/K	100	120
DAF 814 A/K	400	480

Max. average forward rectified current, R-load, For one diode operation only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
For all diodes together		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>

Dauergrenzstrom in Einwegschtaltung mit R-Last, Nur eine Diode im Einsatz	$T_U = 25^\circ\text{C}$	$I_{FAV}$	600 mA <sup>1)</sup>
Für alle Dioden zusammen		$I_{FAV}$	150 mA <sup>1)</sup>

Peak fwd. surge current, 50 Hz half sine-wave, superimposed on rated load, one diode only	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	30 A
Stoßstrom für eine 50 Hz Sinus-Halbwellen, überlagert bei Nennlast, für eine Diode			

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
 Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Max. power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^\circ\text{C}$	$P_{\text{tot}}$	1.2 W <sup>1)</sup>
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		$T_j$	- 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		$T_s$	- 50...+150°C

**Characteristics**

**Kennwerte**

Forward voltage Durchlaßspannung	$T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_F = 1 \text{ A}$	$V_F$	< 1.1 V
Leakage current Sperrstrom	$T_j = 25^\circ\text{C}$ $T_j = 100^\circ\text{C}$	$V_R = V_{\text{RRM}}$ $V_R = V_{\text{RRM}}$	$I_R$ $I_R$	< 10 $\mu\text{A}$ < 90 $\mu\text{A}$
Reverse recovery time Sperrverzug		$I_F = 10 \text{ mA}$ through/über $I_R = 10 \text{ mA}$ to/auf $I_R = 1 \text{ mA}$	$t_{\text{rr}}$	< 350 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			$R_{\text{thA}}$	< 85 K/W <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 3 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 3 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden